腐食研究における SECM の適用

* このドキュメントは、ビー・エー・エス(株)主催によるECセミナーの抄録です。 ECセミナーに関してのお問い合わせは、<u>sales@basj.com</u>にお願い致します。

北海道大学 大学院工学研究科 伏見公志

1 緒言

材料寿命予測を著しく困難にするなどの理由で, 孔食は最も危険な腐食形態であると 言われる。孔食は, 金属試料表面を覆う不働態皮膜が局部的に破壊され, 自己修復で きなくなると進展する。不働態皮膜の局部破壊は, 皮膜の最も弱い部分, あるいは最も 過酷な環境因子にさらされた皮膜部分で生じるものと予想されるが, その位置は従来の 電気化学測定法では解析できなかった。

SECM は, (界面方向に)不均一な溶液/皮膜界面構造を電気化学的に調査すること を特徴とする新しい表面解析法である。SECM は,腐食研究の分野,特に孔食の前駆過 程に関連した研究分野においても適用されはじめている。ここでは,不働態皮膜の不均 一性と局部破壊耐性について SECM を用いて検討した報告例を紹介し,腐食研究の分 野における SECM の適用性について考察する。

2 SECM の基本原理

SECM の原理について簡単に述べる。詳細については,専門書を参考にされたい [1,2]。

微小ディスク電極上で起きる電気化学反応が物質移動律速状態であるとき,その限界 電流 I_{limit} は次式で与えられる[3]。

 $I_{\text{limit}} = 4 \ n \ F \ D \ c^* \ a$

(1)

ここで n は電子移動数, F は Faraday 定数, $D \ge c^*$ は反応物の拡散係数と溶液濃度, a は電極半径である。拡散層の見かけの厚さd は, $d = 4\pi/a \ge c$ なり, 通常電極と比べると極めて薄い。これは, 電極サイズ大の拡散層が半球状に形成するためであり, 微小電極で起こる反応は迅速に定常状態に到達する。

微小電極が試料表面に接近し, 微小電極上の拡散層が空間的制約を受けると, 以下 のように微小電極に流れる限界電流は試料表面の反応活性に応じて変化する。

- 1) 不活性表面: 接近とともに限界電流は減少する(negative feedback)。 試料表面が絶縁 体であるときに見られる。
- 2)活性表面:接近とともに限界電流は増加する(positive feedback)。プローブ電極にお ける生成物をもとの反応物へ化学(電気化学)的に変換可能な試料表面,あるいは 自然浸漬状態の電極表面で見られる。

したがって、プローブ-試料間距離を一定に保ちプローブ電極を走査すると、試料表面 上の反応活性分布に対応するプローブ電流像を得ることができる。

3 不働態皮膜の不均一性評価 鉄やチタンの不働態皮膜は n 型半 導体的性質を有し,アノード分極下, 皮膜内に空間電荷層が形成すること により良好な耐食性を示す。しかし, 皮膜の薄い部分や欠陥構造を多く含 む部分などは電子バリヤー性に乏しく, 皮膜局部破壊の起点になるものと予 想される。こうした皮膜の不均一性を 評価するために, SECM を適用する 試みがいくつか為されている。



図1 Fe(CN)₆⁴⁻/Fe(CN)₆³⁻メディエータを用いた鉄不働 態皮膜の不均一性評価模式図。

レドックス系メディエータ(たとえば,

Fe(CN)₆⁴⁻/Fe(CN)₆³⁻)を添加した溶液中,不働態皮膜を介して起こるメディエータの酸化 (還元)反応は,以下のように皮膜内に形成する空間電荷層の厚さ *dsc* に大きく依存する [4]。

Fe(CN)₆⁴⁻ Fe(CN)₆³⁻ + e⁻ (試料電極) (2)

$$W_{redox} = \exp\left(\frac{-2d_{sc}\sqrt{2m_e\Delta e}}{h}\right)$$
 (3)

ここで, W_{redox} はメディエータの酸化(還元)反応確率, m_e は電子の有効質量,Deは障壁高さである。このため,SECM プローブ電極でメディエータの還元(酸化)反応電流をモニタリングすることにより,皮膜の活性分布を評価することが可能となる(図1参照)。

下地金属	メディエータ	電解質溶液	ref.
Cr	$MV^{+}/MV^{2+} *$	$KCl + MVCl_2$	5
	$Ru(NH_3)_6^{2+}/Ru(NH_3)_6^{3+}$	$K_2SO_4 + Ru(NH_3)_6Cl_3$	5
	$Fe(CN)_{6}^{4}/Fe(CN)_{6}^{3}$	$KCl + K_4Fe(CN)_6$	5
Ti	$Ru(NH_3)_6^{2+}/Ru(NH_3)_6^{3+}$	$KCl + Ru(NH_3)_6Cl_3$	6
	Br/Br_2	$H_2SO_4/K_2SO_4 + KBr$	7, 8,9
	$Fe(CN)_{6}^{4}/Fe(CN)_{6}^{3}$	$K_2SO_4/NaCl/Borate + K_4Fe(CN)_6$	8,9,14,15
	OH ⁻ /O ₂	H_2SO_4	15
Та	I ⁻ /I ₃ ⁻	$K_2SO_4 + KI$	10,11
	$Ru(NH_3)_6^{2+}/Ru(NH_3)_6^{3+}$	$K_2SO_4 + Ru(NH_3)_6Cl_3$	11
	$Fe(CN)_{6}^{4}/Fe(CN)_{6}^{3}$	$K_2SO_4 + K_4Fe(CN)_6$	11
Fe	$Fe(CN)_{6}^{4}/Fe(CN)_{6}^{3}$	Borate + K_4 Fe(CN) ₆	12, 13

表1 SECM による不働態皮膜の不均一性評価実施例

*MV: methyl viologen

 Fe(CN)₆³⁻ + e⁻
 Fe(CN)₆⁴⁻
 (プローブ電極)
 (4)

 既に報告されているこの種の方法による皮膜評価例を表1にまとめる。

レドックス系メディエータ(Ru(NH₃)₆²⁺/Ru(NH₃)₆³⁺, Fe(CN)₆⁴⁻/Fe(CN)₆³⁻など)は,皮膜 に特異吸着せずに(外圏電子移転型)酸化還元反応するとされており,皮膜の不均一性 評価に多く用いられている[9,11,12,14-18]。Fushimi らは,Fe(CN)₆⁴⁻/Fe(CN)₆³⁻をメディエ ータに用いて,多結晶鉄[16]あるいはチタン[17]電極上に形成する不働態皮膜が下地 結晶面方位により異なり(図3参照),疎な原子密度を有する面(鉄の場合,{100}面)上 でバリヤー性の高い皮膜が形成することを報告している[16]。



図 2 a) pH8.4 ホウ酸水溶液中,1 V(SHE)で不働態化した多結晶鉄電極上のレドックス反応分布。b) a を測定した部分の光学顕微鏡写真(下地結晶粒の面方位はエッチピット法により求めた)。

チタンやタンタルのようなバルブ金属上に形成する酸化物皮膜は,比較的安定なので, SECMによってよく調べられている。上述のレドックス系メディエータを用いた皮膜の不均 一性評価の他,ハロゲン系メディエータ(Br⁻/Br₂,I⁻/I₃ など)を利用して,一連の皮膜局部 破壊挙動の観察が行われている[7-11]。たとえば Basame らは,試料電極およびプロー ブ電極で以下の反応がおこることを利用してタンタル酸化物皮膜表面を SECM 観察し, 自然酸化皮膜表面に活性分布が存在し,皮膜成長とともに個々の活性部は独立して成 長あるいは死滅することを報告している[10,11]。

$3I^{-}$ $I_{3}^{-} + 2e^{-}$	(試料電極)	(5)
$I_3^{-} + 2e^{-}$ $3I^{-}$	(プローブ電極)	(6)

人為的にメディエータを添加した溶液を用いるこれらの SECM 測定では,添加メディエ ータの皮膜に対する影響を全く無視することはできない。これに対して,試料電極表面 から不働態皮膜を介して発生する反応生成物をメディエータとして利用し,皮膜の不均 一性を評価する試みもなされている。Fushimi らは,チタン電極のアノード酸化の際に発 生する酸素を SECM プローブ電極で還元検出することにより,チタン酸化物皮膜の不均 一性を評価することができることを示した[15]。

$2H_2O$	$O_2 + 4H$	$+ + 4e^{-1}$	(試料電極)	(7)
$O_2 + 4H^+$	+ 4e ⁻	$2H_2O$	(プローブ電極)	(8)

この場合,酸素発生の反応活性部位と添加した Fe(CN)6⁴⁻/Fe(CN)6³⁻メディエータの反応 活性部位は,一致することがわかった。また,皮膜の成長と破壊にともない,酸素発生反 応の活性部位が新たに出現することが明らかになった。

4 下地金属中の介在物

ステンレス鋼などの高耐食性材料では,金属材料中の介在物が局部腐食の基点となることが知られている。Paik らは,NaCl 水溶液中のステンレス鋼の腐食挙動について I/I₃メディエータを用いて調査した[16]。SECM 測定スキームは次の通りである。介在物 MnS の溶解は以下のように示される。

 $MnS + 2Cl^{-} MnCl_{2} + S^{2-} S^{2-} + H^{+} HS^{-}$ (9a)

 $2MnS + 4Cl^{-} + 3H_2O \qquad S_2O_3^{-2-} + 2MnCl_2 + 6H^{+} + 8e^{-1}$ (9b)

腐食生成物 HS あるいは S2O32は,直ちに溶液中のメディエータ I3 を還元する。

$$I_{3}^{-} + HS^{-} \qquad 3I^{-} + H^{+} + S \qquad (MnS \perp) \qquad (10a)$$
$$I_{3}^{-} + S_{2}O_{3}^{-2} \qquad 3I^{-} + S_{4}O_{6}^{-2-} \qquad (MnS \perp) \qquad (10b)$$

したがって, プローブ電極における I の酸化・検出反応速度は, 介在物の溶解速度に対応する。

$$3I^{-}$$
 $I_{3}^{-} + 2e^{-}$ (プローブ電極) (11)

5 不働態皮膜の局部破壊

上で述べたように, SECM のプローブ電流像を測定することにより,不働態皮膜の不均 一性を評価できる。しかしながら,試料"平面"に対して"点"であるプローブ電極を走査 する以上,試料全面の経時変化を連続して測定することは不可能である。孔食前駆過 程のように局部反応のイベントが迅速である場合,プローブ電流像にそのイベントが反 映されないことも十分におこり得る。一方,プローブ電極を走査せずに試料表面上の特 定位置に固定すると,その特定位置における時々刻々変化する電気化学的反応活性を 追跡することができる。更にプローブ電極で皮膜の変質に寄与する化学種を電気化学 的に局部発生させることにより,試料表面の特定位置における皮膜の局部破壊過程の 詳細を調査することが可能となる。

Wipf らは,トリクロロ酢酸をメディエータとして用い,CFイオンを還元発生させ,ステンレス綱[17]や鉄[18]電極表面に形成した不働態皮膜の局部破壊に成功している。

 $Cl_3COOH + H_2O + 2e^{-1}$ $Cl_2HCOOH + OH^{-1} + Cl^{-1}$ (12)

Fushimi らは,銀/塩化銀微小電極をプロ ーブ電極として用い,これを還元することによ り発生させた CFイオンにより鉄不働態皮膜を 局部破壊させ,その破壊過程が以下の3つ に区別されることを報告している(図3参照) [19]。

誘導過程: プローブ / 鉄電極間の局所空 間に濃縮した CIイオンにより, 皮膜欠陥構造 の導入あるいは皮膜の変質と皮膜の微小溶 解が起こるが, 不働態は保持される。

$$AgCl + e^{-}$$
 $Ag + Cl^{-}$ (13)

皮膜破壊過程:皮膜の欠陥構造および変 質が臨界値を越えて,皮膜の急激な溶解が 始まる。プローブ電極では,鉄から溶出した Fe³⁺イオンの還元反応が,また,プローブ電 極直下の鉄表面では皮膜を介して Fe²⁺イオ ンの酸化反応が繰り返される positive feedback が進行する。

局部腐食進展過程:皮膜破壊部において 下地の鉄が Fe²⁺イオンとして溶解する。

Fe
$$Fe^{2+} + 2e^{-}$$
 (16)

の継続時間は,皮膜破壊の誘導時間に他 ならない。誘導時間は,膜厚,皮膜中の欠陥 濃度,皮膜にかかる電場に依存することが明 らかになっている。



図3 LPIG による鉄不働態皮膜破壊にともなう 電流応答とその解釈。(IE:鉄電極, ME: LPIG 微小電極。pH6.5 ホウ酸塩 水溶液中,鉄電極を 0.7 V (SHE)で不働 態化した後,LPIG 微小電極電位を-0.1 V(SHE)にステップした。)

6 実用材料への適用

以上,不働態領域ならびに局部腐食の前駆過程に関するSECMの適用例を簡単に紹介した。この他,重要な腐食反応のひとつに活性溶解反応があげられる。活性溶解反応のSECM測定は,溶解反応にともなう試料表面形状が速やかに変化する。特に溶解反応が試料ほぼ全面で起こる場合,明確な電流分布を得にくいなどを理由に難しい

が,将来的に多様な報告が予想される。

実用材料の腐食系にSECMを適用する場合,その試料の多くは凹凸を有し,要求され るプローブ電流像の面分解能は1µm以下であろう。特に,腐食系試料の表面状態は不 可逆的に変化することが,長短両方の特徴である。安定に高精度のSECM測定を行うた めには,試料を電気化学セルに装着してから迅速にSECM測定を開始する必要がある。 このような性状を持つ試料に対する測定装置の改良例は既に報告されている[1,2]。今 後の装置メーカーの努力に大いに期待したい。

参考文献

- A.J. Bard, F.-R.F. Fan and M.V. Mirkin, in "*Electroanalytical Chemistry*", Vol. 18, A.J. Bard, Editor, p. 243, Marcel Dekker, New York (1994).
- 2. A.J. Bard and M.V. Mirkin, "Scanning Electrochemical Microscopy", Marcel Dekker, New York (2001).
- 3. Y. Saito, Rev. Polarogr. Jpn., 15, 177 (1968).
- 4. J.W. Schultze and L. Elfenthal, J. Electroanal. Chem., 204, 153 (1986).
- 5. C. Lee and A.J. Bard, Anal. Chem., 62, 1906 (1990).
- 6. C. Wei and A.J. Bard, J. Electrochem. Soc., 142, 2523 (1995).
- N. Casillas, S.J. Charlebois, W.H. Smyrl and H.S. White, J. Electrochem. Soc., 140, L142 (1993); 141, 636 (1994).
- 8. S.B. Basame and H.S. White, J. Phys. Chem., 99, 16430 (1995).
- 9. S.B. Basame and H.S. White, J. Phys. Chem. B, 102, 9812 (1998).
- 10. S.B. Basame and H.S. White, Anal. Chem., 71, 3166 (1999).
- 11. S.B. Basame and H.S. White, Lungmuir, 15, 819 (1999).
- 12. 伏見公志, 瀬尾眞浩, 材料と環境, 46, 797 (1997).
- 13. K. Fushimi, K. Azumi and M. Seo, ISIJ Int., 39, 346 (1999).
- 14. K. Fushimi, T. Okawa, K. Azumi and M. Seo, J. Electrochem. Soc., 147, 524 (2000).
- 15. K. Fushimi, T. Okawa and M. Seo, *Electrochemistry*, 68, 950 (2000).
- 16. C.H. Paik, H.S. White, and R.C. Alkire, J. Electrochem. Soc., 147, 4120 (2000).
- 17. D.O. Wipf, Collo. Surf. A, 93, 251 (1994).
- 18. J.W. Still and D.O. Wipf, J. Electrochem. Soc., 144, 2657 (1997).
- 19. K. Fushimi, K. Azumi, M. Seo, J. Electrochem. Soc., 147, 552 (2000).